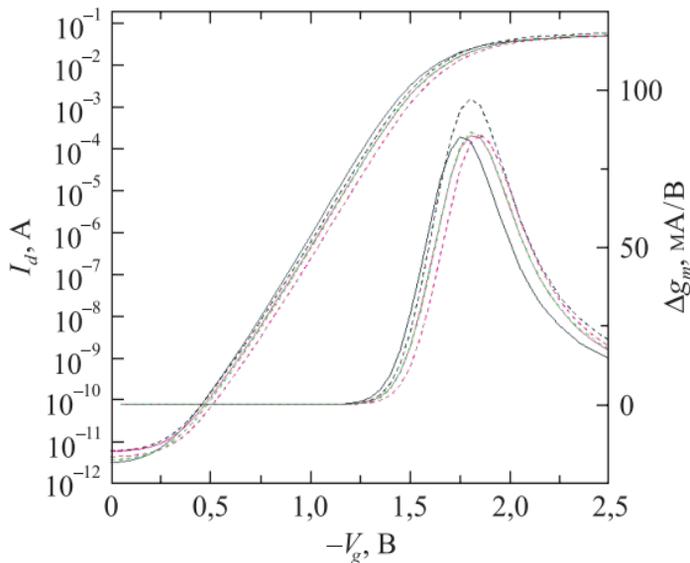
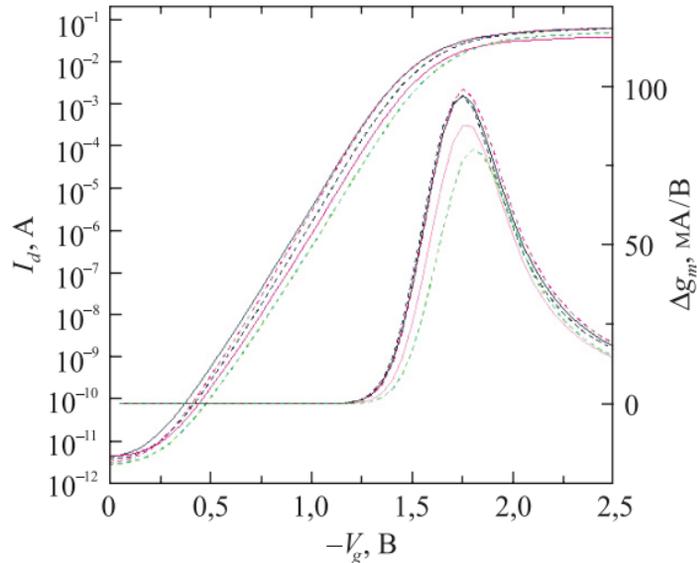


a/a*b/b*

— W/O - - - N^+ ($D_{N^+} = 1 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-2}$, $E = 20 \text{ кэВ}$) - - - N^+ ($D_{N^+} = 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-2}$, $E = 40 \text{ кэВ}$)
 — N^+ ($D_{N^+} = 5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-2}$, $E = 20 \text{ кэВ}$) - - - N^+ ($D_{N^+} = 5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$, $E = 20 \text{ кэВ}$)

Рис. 6. Зависимости тока стока (I_d) и крутизны ВАХ (Δg_m) МОП-транзисторов в триодном режиме ($V_d = -0,1 \text{ В}$) от напряжения на затворе (V_g) в диапазоне 0–2,5 В для контрольных (W/O) и имплантированных (N^+) образцов:

a – прямой порядок БТО; *b* – обратный порядок БТО

Fig. 6. Dependences of the drain current (I_d) and the current-voltage slope (Δg_m) of MOSFETs in the triode mode ($V_d = -0.1 \text{ V}$) on the gate voltage (V_g) in the range 0–2.5 V for control (W/O) and implanted (N^+) samples:

a – direct order of rapid thermal annealing; *b* – reverse order of rapid thermal annealing